

無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM 型スイッチング電源用パワーIC



# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

## 概要

STR3A100 シリーズは、パワーMOSFET と電流モード型 PWM 制御 IC を 1 パッケージにした PWM 型スイッチング電源用パワーIC です。

低消費電力および低スタンバイ電力に対応するため、起動回路とスタンバイ機能を内蔵しており、通常動作時は PWM 動作、軽負荷時はバースト発振動作へ自動的に切り替わります。充実した保護機能により、構成部品が少なく、コストパフォーマンスの高い電源システムを容易に構成できます。

## 特長

- 電流モード型 PWM 制御
- ランダムスイッチング機能内蔵  
(EMI ノイズの低減、EMI 対策用フィルタの簡素化、外付け部品削減によるコストダウン)
- スロープ補正機能搭載  
(サブハーモニック発振の防止)
- リーディング・エッジ・ブランキング機能内蔵
- オートスタンバイ機能内蔵  
無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$   
(低消費シャントレギュレータ使用時)  
通常動作時は PWM モード、スタンバイ時(軽負荷時)はスタンバイモードでバースト発振動作
- ソフトスタート機能内蔵  
(電源起動時のパワーMOSFET および 2 次側整流ダイオードのストレス低減)
- 保護機能  
入力補正機能付き過電流保護(OCP)  
-----パルス・バイ・パルス方式  
タイマ内蔵型過負荷保護(OLP)----- 自動復帰  
過電圧保護(OVP)----- 自動復帰  
過熱保護(TSD)----- 自動復帰

## パッケージ

DIP8



## 主要スペック

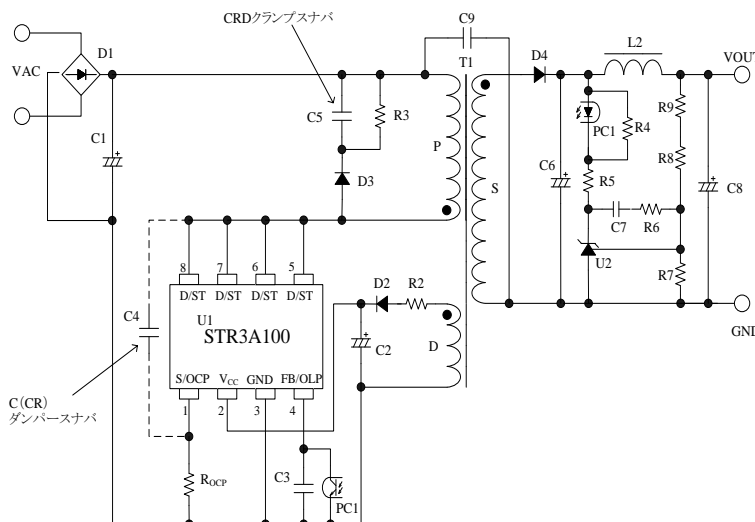
- 平均発振周波数  $f_{OSC(AVG)}(TYP) = 100kHz$
- MOSFET スペック、出力電力  $P_{OUT}$

製品名	MOSFET		$P_{OUT}$	
	$V_{DSS}$ (MIN)	$R_{DS(ON)}$ (MAX)	AC230V	Universal
STR3A161HD	700V	4.2Ω	26W	17W
STR3A162HD	700V	3.2Ω	29W	20W
STR3A163HD	700V	2.2Ω	35W	29W

## アプリケーション

- スタンバイ電源用  
LCDTV、PDPTV、デスクトップ PC、LBP、オーディオなど
- 小型 SMPS 用  
プリンタ、BD/DVD プレーヤ、セットトップボックスなど
- コントローラ用補助電源  
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、食器洗い機など

## 応用回路例



無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM 型スイッチング電源用パワーIC



# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

絶対最大定格<sup>(1)</sup> ( $T_a=25^\circ C$ )

項目	端子	記号	測定条件	規格値	単位	備考
ドレインピーク電流 <sup>(2)</sup>	8-1	$I_{DPEAK}$	シングルパルス	3.6	A	STR3A161HD
				4	A	STR3A162HD
				4.8	A	STR3A163HD
アバランシェエネルギー耐量 <sup>(3)</sup> (シングルパルス)	8-1	$E_{AS}$	$I_{LPEAK}=1.43A$	23.8	mJ	STR3A161HD
			$I_{LPEAK}=1.58A$	29	mJ	STR3A162HD
			$I_{LPEAK}=1.88A$	41	mJ	STR3A163HD
S / O C P 端子電圧	1-3	$V_{OCP}$		-2~6	V	
制御部電源電圧	2-3	$V_{CC}$		32	V	
F B / O L P 端子電圧	4-3	$V_{FB}$		-0.3~14	V	
F B / O L P 端子電流	4-3	$I_{FB}$		1.0	mA	
M O S F E T 部許容損失 <sup>(4)</sup>	8-1	$P_{D1}$	基板実装時 基板サイズ 15mm×15mm	1.68	W	STR3A161HD /62HD
				1.76	W	STR3A163HD
制御部許容損失 (M I C)	2-3	$P_{D2}$		1.3	W	$V_{CC} \times I_{CC}$ で規定
動作周囲温度	—	$T_{OP}$		-40~+125	°C	
保存温度	—	$T_{stg}$		-40~+125	°C	
チャンネル温度	—	$T_{ch}$		+150	°C	

<sup>(1)</sup>電流値の極性は IC を基準として、シンクが(+), ソースが(-)と規定

<sup>(2)</sup> MOS FET A.S.O. 曲線参照

<sup>(3)</sup> MOS FET  $T_{ch}-E_{AS}$  曲線参照

<sup>(4)</sup> MOS FET  $T_a-P_{D1}$  曲線参照

無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM型スイッチング電源用パワーIC



# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

制御部電気的特性<sup>(1)</sup> (特記のない場合の条件  $V_{CC}=18V$ 、 $T_a=25^{\circ}C$ )

項目	端子	記号	規格値			単位	備考
			MIN	TYP	MAX		
動作開始電源電圧	2-3	$V_{CC(ON)}$	13.8	15.3	16.8	V	
動作停止電源電圧 <sup>(2)</sup>	2-3	$V_{CC(OFF)}$	7.3	8.1	8.9	V	
動作時回路電流	2-3	$I_{CC(ON)}$	—	—	2.5	mA	$V_{CC} = 12V$
最低起動電圧	8-3	$V_{ST(ON)}$	—	40	—	V	
起動電流	2-3	$I_{STARTUP}$	-3.9	-2.5	-1.1	mA	$V_{CC} = 13.5V$
起動電流供給しきい電圧 <sup>(2)</sup>	2-3	$V_{CC(BIAS)}$	8.5	9.5	10.5	V	
平均発振周波数	8-3	$f_{OSC(AVG)}$	90	100	110	kHz	
発振周波数変動幅	8-3	$\Delta f$	—	8	—	kHz	
最大 ON Duty	8-3	$D_{MAX}$	77	83	89	%	
リーディング・エッジ・ブランキング時間	—	$t_{BW}$	—	280	—	ns	
過電流補正值	—	DPC	—	27	—	mV/ $\mu s$	
過電流補正制限 Duty	—	$D_{DPC}$	—	36	—	%	
ゼロ ON duty 時 OCP しきい電圧	1-3	$V_{OCP(L)}$	0.69	0.78	0.87	V	
36% duty 時 OCP しきい電圧	1-3	$V_{OCP(H)}$	0.79	0.88	0.97	V	
最大フィードバック電流	4-3	$I_{FB(MAX)}$	-110	-70	-35	$\mu A$	
最小フィードバック電流	4-3	$I_{FB(MIN)}$	-30	-15	-7	$\mu A$	
発振停止 FB/OLP 電圧	4-3	$V_{FB(OFF)}$	1.09	1.21	1.33	V	$V_{CC} = 32V$
OLP しきい電圧	4-3	$V_{FB(OLP)}$	7.3	8.1	8.9	V	$V_{CC} = 32V$
OLP 動作後回路電流	2-3	$I_{CC(OLP)}$	—	230	—	$\mu A$	$V_{CC} = 12V$
OLP 遅延時間	—	$t_{OLP}$	54	70	86	ms	
FB/OLP 端子クランプ電圧	4-3	$V_{FB(CLAMP)}$	11.0	12.8	14.0	V	
OVP しきい電圧	2-3	$V_{CC(OVP)}$	27.5	29.5	31.5	V	
熱保護動作温度	—	$T_{j(TSD)}$	135	—	—	$^{\circ}C$	

<sup>(1)</sup> 電流値の極性は IC を基準として、シンクが(+), ソースが(-)と規定

<sup>(2)</sup>  $V_{CC(BIAS)} > V_{CC(OFF)}$  の関係が成り立つ

無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM 型スイッチング電源用パワーIC



# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

## MOSFET 部電氣的特性<sup>(1)</sup> ( $T_a = 25^\circ C$ )

項目	端子	記号	規格値			単位	備考
			MIN	TYP	MAX		
ドレイン・ソース間電圧	8-1	$V_{DSS}$	700	—	—	V	
ドレイン漏れ電流	8-1	$I_{DSS}$	—	—	300	$\mu A$	
ON 抵抗	8-1	$R_{DS(ON)}$	—	—	4.2	$\Omega$	STR3A161HD
			—	—	3.2	$\Omega$	STR3A162HD
			—	—	2.2	$\Omega$	STR3A163HD
スイッチング・タイム	8-1	$t_f$	—	—	250	ns	
熱抵抗 <sup>(2)</sup>	—	$\theta_{ch-C}$	—	—	18	$^\circ C/W$	

<sup>(1)</sup> 電流値の極性は IC を基準として、シンクが(+), ソースが(-)と規定

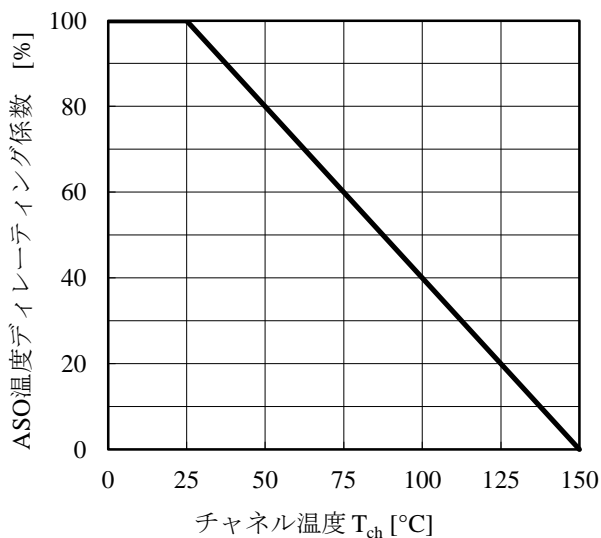
<sup>(2)</sup> MOSFET のチャンネルと、ケース間の熱抵抗。ケース温度は捺印面中央部で規定

# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

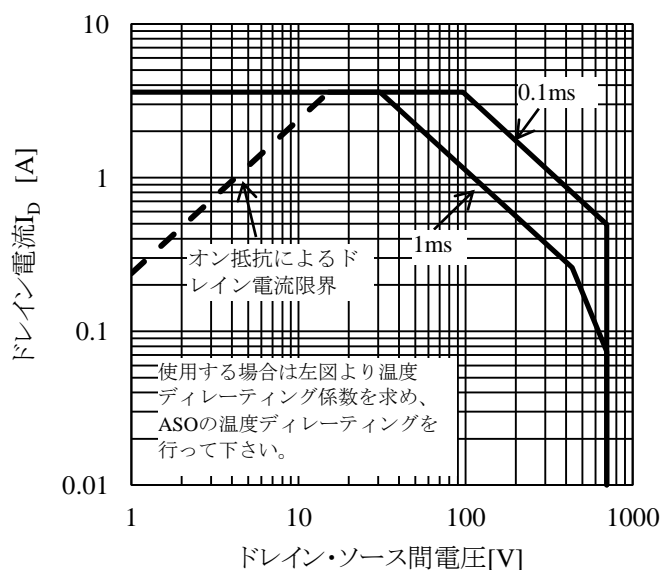
## STR3A161HD MOSFET 代表特性

ASO温度ディレーティング係数曲線

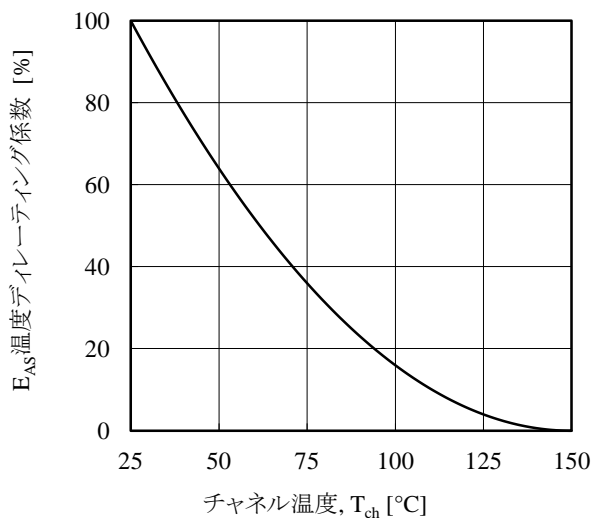


MOSFET ASO曲線

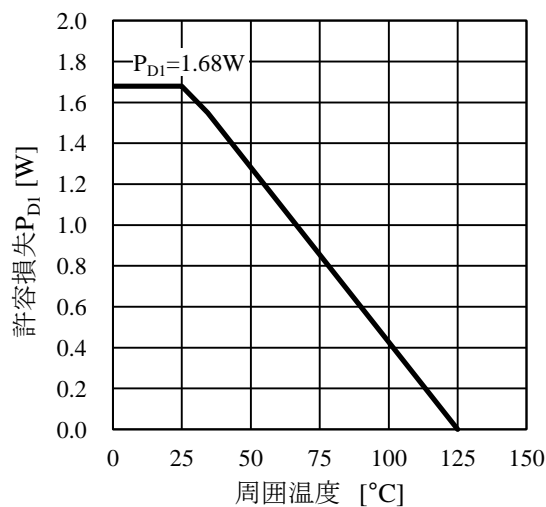
$T_a = 25^\circ C$  Single pulse



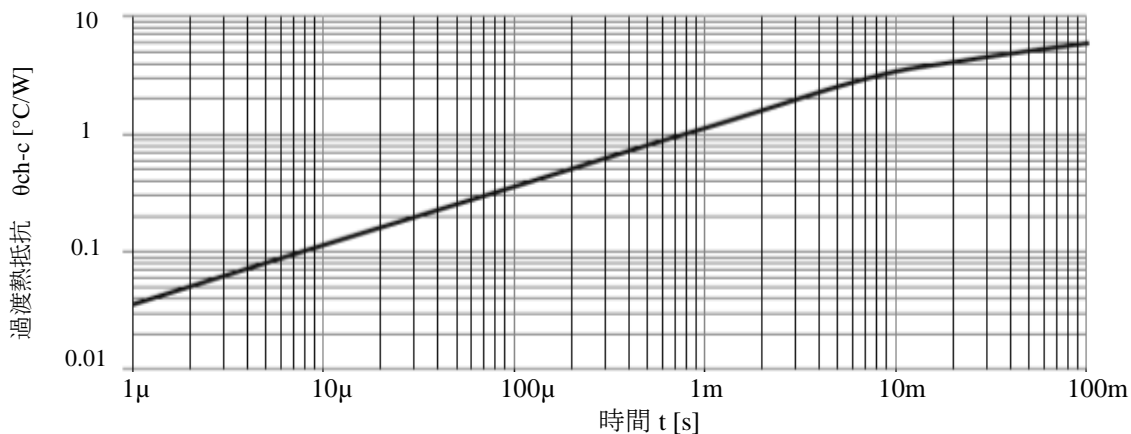
アバランシェ・エネルギー耐量  
ディレーティング曲線



MOSFET  $T_a$ - $P_{D1}$ 曲線



過渡熱抵抗曲線



無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM 型スイッチング電源用パワーIC



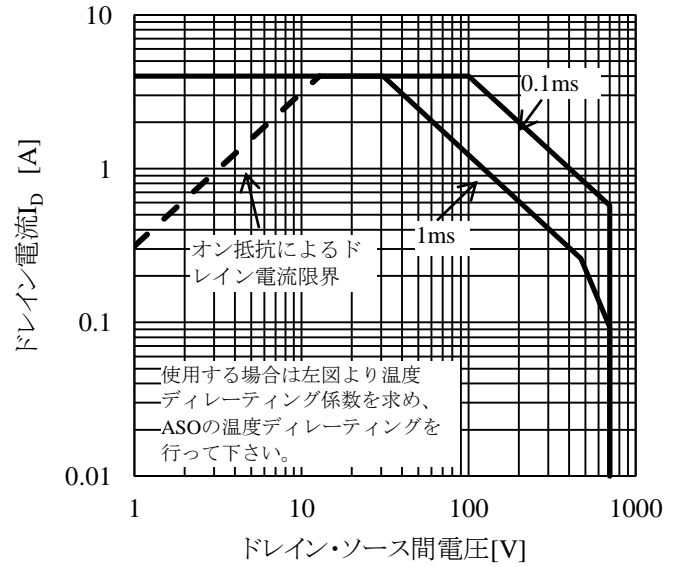
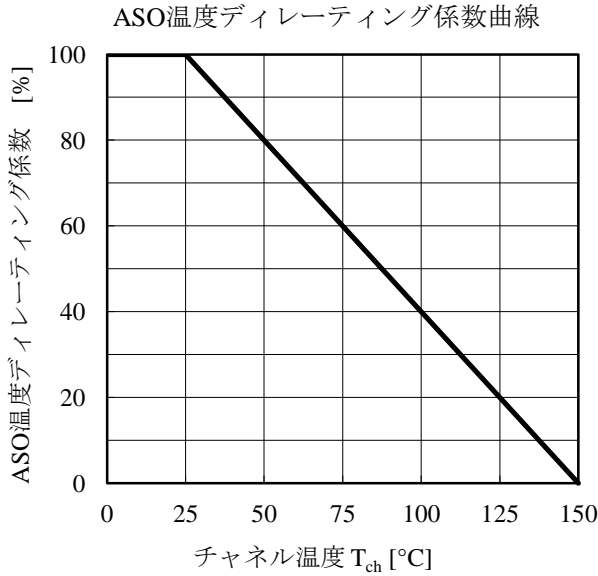
# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

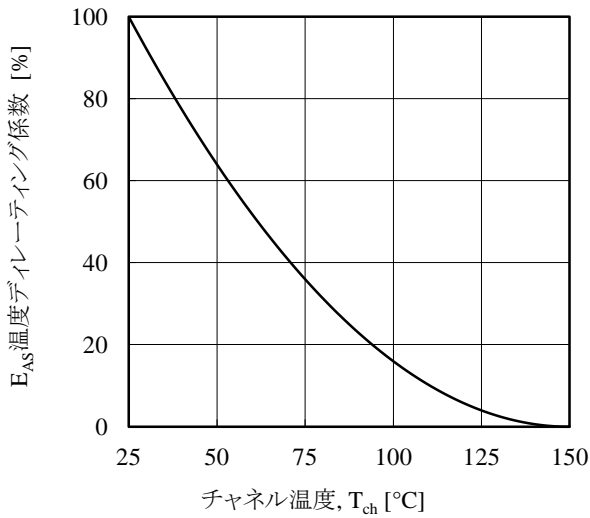
## STR3A162HD MOSFET 代表特性

### MOSFET ASO曲線

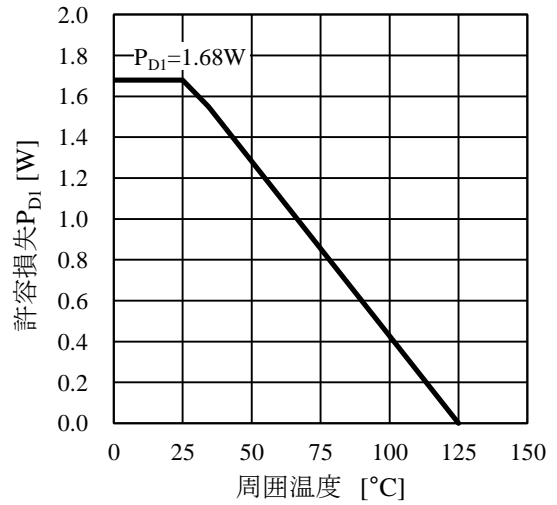
$T_a = 25^\circ C$  Single pulse



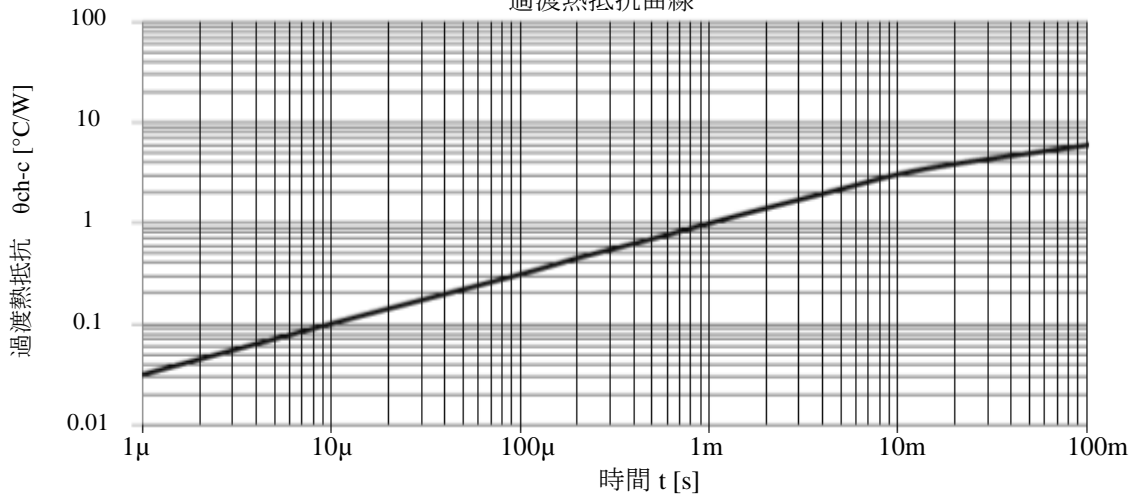
### アバランシェ・エネルギー耐量 ディレーティング曲線



### MOSFET $T_a$ - $P_{D1}$ 曲線



### 過渡熱抵抗曲線



無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM型スイッチング電源用パワーIC

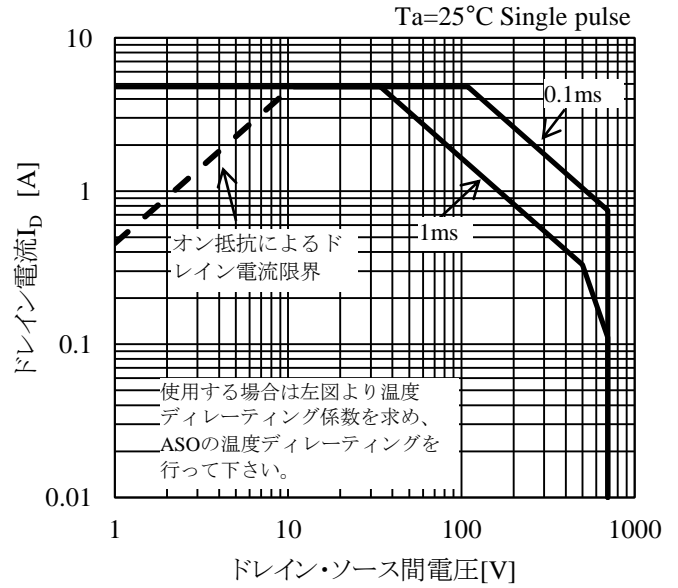
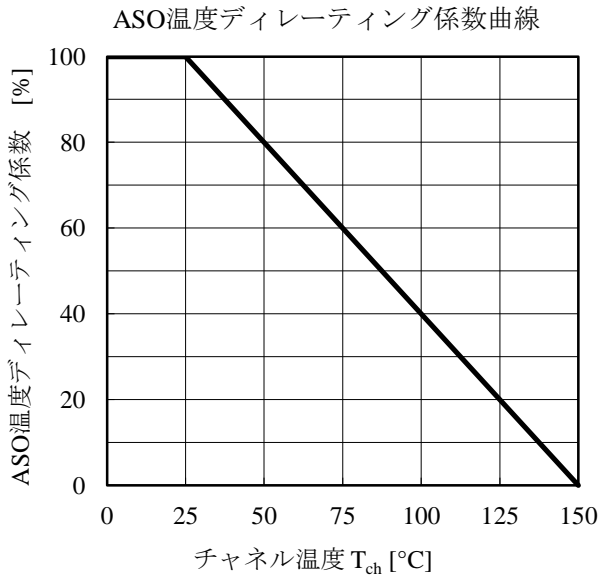


# STR3A161HD/62HD/63HD

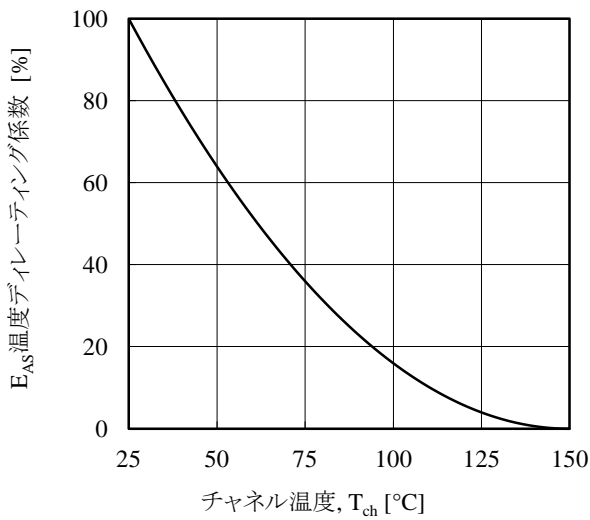
2012年7月20日

## STR3A163HD MOSFET 代表特性

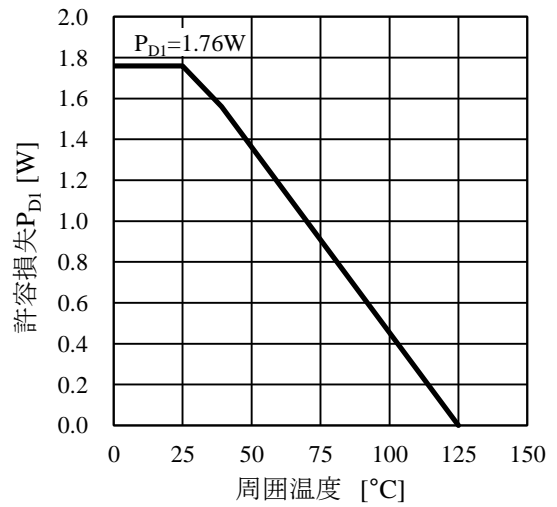
MOSFET ASO曲線



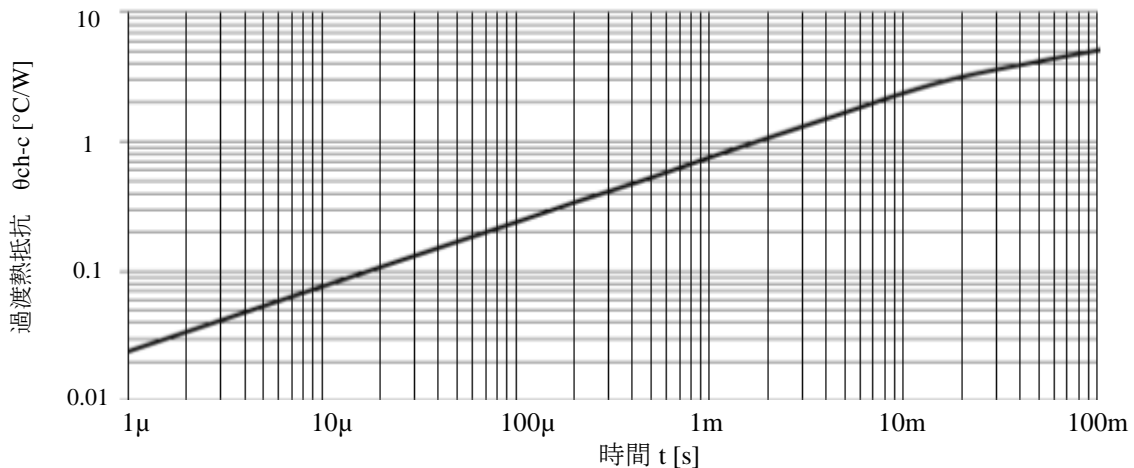
アバランシェ・エネルギー耐量  
ディレーティング曲線



MOSFET  $T_a$ - $P_{D1}$  曲線



過渡熱抵抗曲線



無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

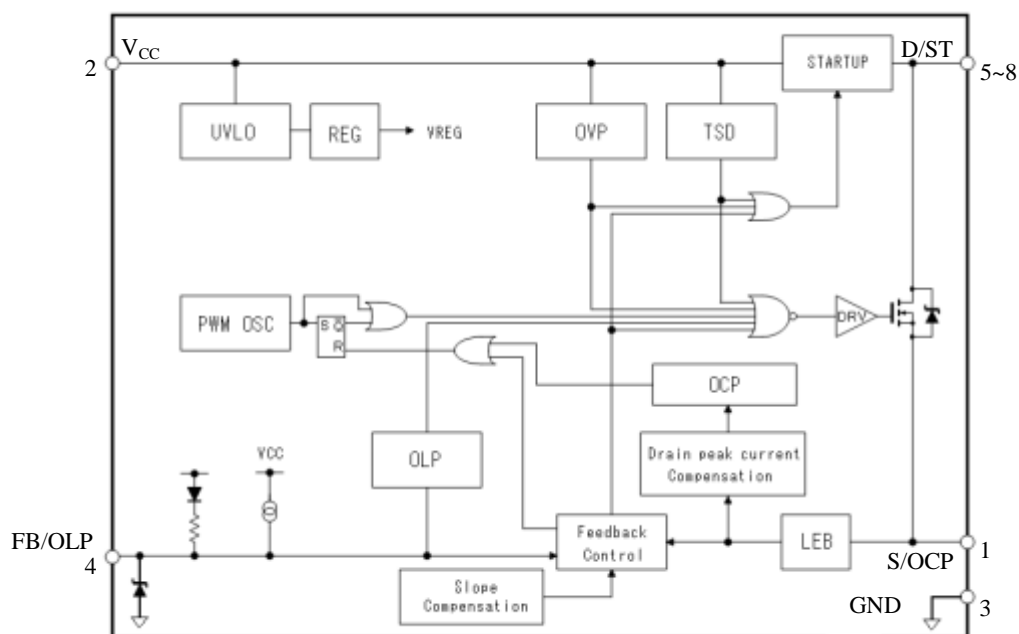
$f_{OSC} = 100kHz$  PWM 型スイッチング電源用パワーIC



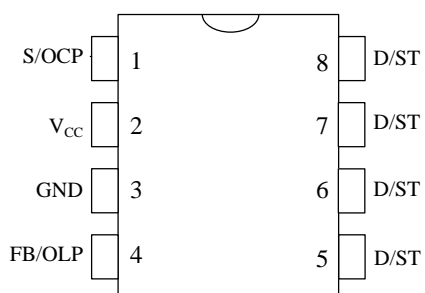
# STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

## ブロックダイアグラム



## 各端子機能



端子番号	記号	機能
1	S/OCP	MOSFET ソース／過電流検出信号入力
2	V <sub>CC</sub>	制御回路電源入力／過電圧検出信号入力
3	GND	グラウンド
4	FB /OLP	定電圧制御信号入力／過負荷保護信号入力
5	D/ST	MOSFET ドレイン／起動電流入力
6		
7		
8		



無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

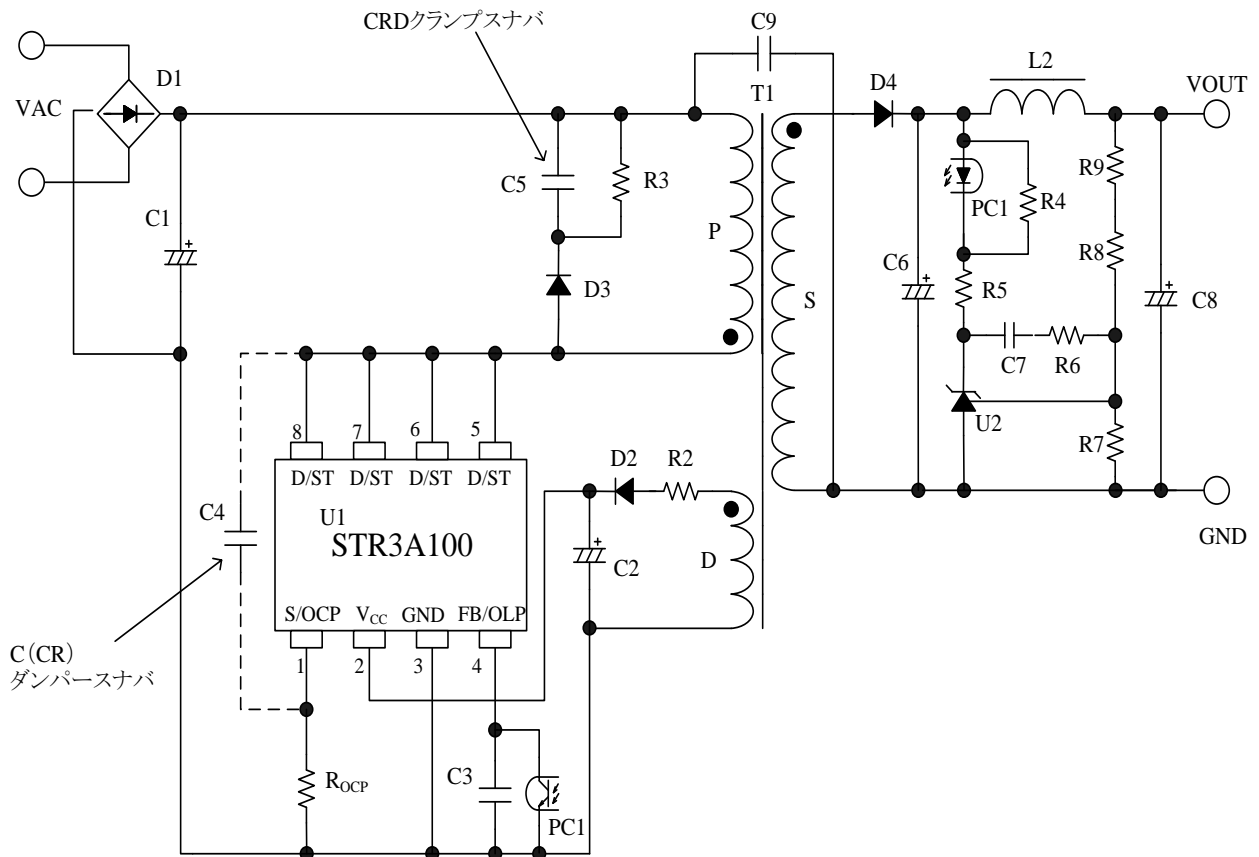
$f_{OSC} = 100kHz$  PWM型スイッチング電源用パワーIC

# STR3A161HD/62HD/63HD



2012年7月20日

## 応用回路例



無負荷時入力電力  $P_{IN} < 10mW$

$f_{OSC} = 100kHz$  PWM 型スイッチング電源用パワーIC

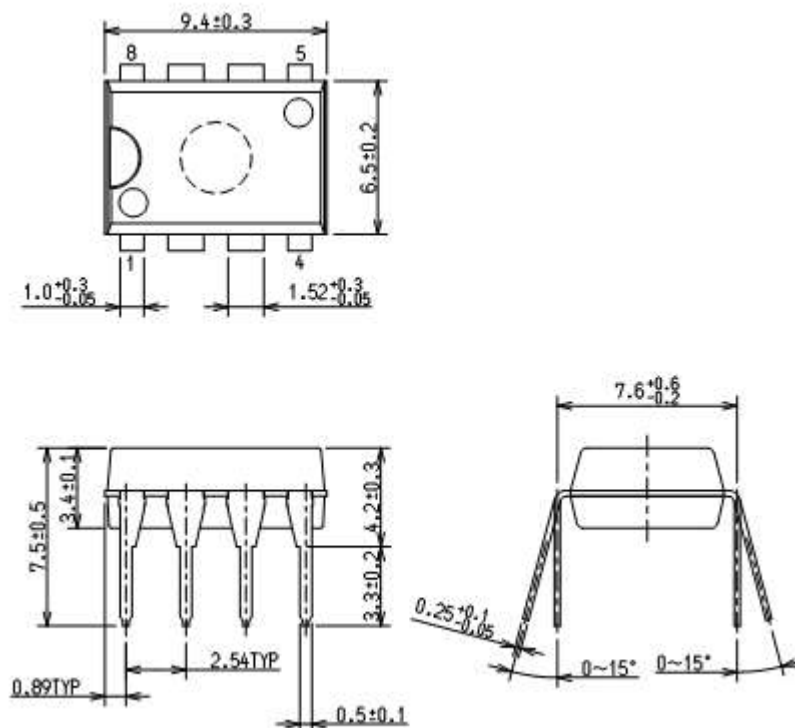
# STR3A161HD/62HD/63HD

SanKen

2012年7月20日

## 外形寸法

DIP8

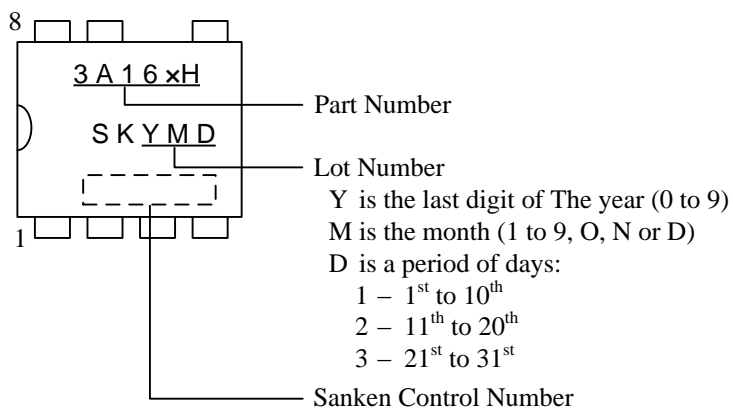


### NOTES:

- 1) 単位 : mm
- 2) Pb フリー品 (RoHS 対応)

## 捺印仕様

STR3A16×HD



## STR3A161HD/62HD/63HD

2012年7月20日

## 使用上の注意

保管環境、特性検査上の取り扱い方法によっては信頼度を損なう要因となるので、注意事項に留意してください。

## 保管上の注意事項

- 保管環境は、常温（5～35℃）、常湿（40～75%）中が望ましく、高温多湿やの場所、温度や湿度の変化が大きな場所を避けてください
- 腐食性ガスなどの有毒ガスが発生しない、塵埃の少ない場所で、直射日光を避けて保管してください
- 長期保管したものは、使用前にはんだ付け性やリードの錆などについて再点検してください

## 特性検査、取り扱い上の注意事項

- 受入検査などで特性検査を行う場合は、測定器からのサージ電圧の印加、端子間ショートや誤接続などに十分注意してください。また定格以上の測定は避けてください

## 放熱用シリコングリースを使用する場合の注意事項

- 本製品を放熱板に取り付け、シリコングリースを使用する場合は、均一に薄く塗布してください。必要以上に塗布すると、無理な応力を加えます
- 揮発性の放熱用シリコングリースは、長時間経過するとシリコングリースにヒビ割れが生じ、放熱効果が悪化します。ちよう度の小さい（固い）放熱用シリコングリースは、ビス止め時にモールド樹脂クラックの原因となります  
弊社では、寿命に影響を与えない下記の放熱用シリコングリースを推奨しております

品名	メーカー名
G746	信越化学工業(株)
YG6260	モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社
SC102	東レ・ダウコーニング(株)

## はんだ付け方法

- はんだ付けをする場合は、下記条件以内で、できるだけ短時間で作業してください
  - ・260±5℃ 10±1 s（フロー、2回）
  - ・380±10℃ 3.5±0.5 s（はんだごて、1回）
 はんだ付けは製品本体より1.5mmのところまでとします。

## 静電気破壊防止のための取扱注意

- 製品を取り扱う場合は、人体アースを取ってください。人体アースはリストストラップなどを用い、感電防止のため、1MΩの抵抗を人体に近い所へ入れてください
- 製品を取り扱う作業台は、導電性のテーブルマットやフロアマットなどを敷き、アースを取ってください
- カーブトレーサーなどの測定器を使う場合、測定器もアースを取ってください
- はんだ付けをする場合、はんだごてやディップ槽のリーク電圧が、製品に印加するのを防ぐため、はんだごての先やディップ槽のアースを取ってください。
- 製品を入れる容器は、弊社出荷時の容器を用いるか、導電性容器やアルミ箔などで、静電対策をしてください

## 注意書き

- 本資料に記載している内容は、改良などにより予告なく変更することがあります。  
ご使用の際には、最新の情報であることを確認してください。
- 本書に記載している動作例および回路例は、使用上の参考として示したもので、これらに起因する弊社もしくは第三者の工業所有権、知的所有権、その他の権利の侵害問題について弊社は一切責任を負いません。
- 弊社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品では、ある確率での欠陥、故障の発生は避けられません。製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害などが発生しないよう、使用者の責任において、装置やシステム上で十分な安全設計および確認を行ってください。
- 本書に記載している製品は、一般電子機器（家電製品、事務機器、通信端末機器、計測機器など）に使用することを意図しております。  
高い信頼性を要求する装置（輸送機器とその制御装置、交通信号制御装置、防災・防火装置、各種安全装置など）への使用を検討、および一般電子機器であっても長寿命を要求する場合は、必ず弊社販売窓口へ相談してください。  
極めて高い信頼性を要求する装置（航空宇宙機器、原子力制御、生命維持のための医療機器など）には、弊社の文書による合意がない限り使用しないでください。
- 弊社の製品を使用、またはこれを使用した各種装置を設計する場合、定格値に対するディレーティングをどの程度行うかにより、信頼性に大きく影響します。  
ディレーティングとは信頼性を確保または向上するため、各定格値から負荷を軽減した動作範囲を設定したり、サージやノイズなどについて考慮したりすることです。ディレーティングを行う要素には、一般的に電圧、電流、電力などの電氣的ストレス、周囲温度、湿度などの環境ストレス、半導体製品の自己発熱による熱ストレスがあります。これらのストレスは、瞬間的数値、あるいは最大値、最小値についても考慮する必要があります。  
なおパワーデバイスやパワーデバイス内蔵 IC は、自己発熱が大きく接合部温度のディレーティングの程度が、信頼性を大きく変える要素となるので十分に配慮してください。
- 本書に記載している製品の使用にあたり、本書記載の製品に他の製品・部材を組み合わせる場合、あるいはこれらの製品に物理的、化学的、その他何らかの加工・処理を施す場合には、使用者の責任においてそのリスクを検討の上行ってください。
- 本書記載の製品は耐放射線設計をしておりません。
- 弊社物流網以外での輸送、製品落下などによるトラブルについて、弊社は一切責任を負いません。
- 本書記載の内容を、文書による当社の承諾なしに転記複製を禁じます。